

3SK47

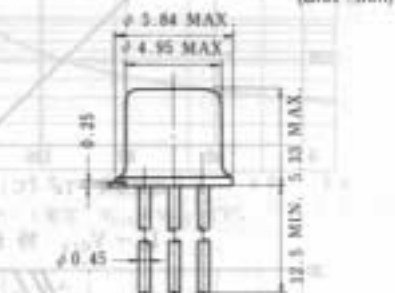
NチャンネルMOS形シリコン電界効果トランジスタ(デュアルゲート) N-channel Silicon MOS FET High Frequency Amplifier and Voltage Controlled Resistor Industrial Use

高周波増幅用, 可変抵抗用素子
通信工業用

○VHF, RF, MIX用および可変抵抗用素子に最適です。



外形図/PACKAGE DIMENSIONS
(Unit: mm)



絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25 °C)

項目	略号	定格	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSX}	20	V
ゲート1・ソース間電圧	V_{G1S}	± 7.0	V
ゲート2・ソース間電圧	V_{G2S}	± 7.0	V
ドレイン電流	I_D	25	mA
全消耗電力	P_T	300	mW
チャンネル温度	T_{ch}	150	°C
保存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	°C

電極接続

1. Drain 3. Gate 1
2. Gate 2 4. Source, Sub. (Case)

EIAJ: TC-7, TB-9C

JEDEC: TO 206MD (TO-72)

IEC: C7, B12

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
ドレイン・ソース間電圧	V_{DSX}	$I_D=100 \mu A, V_{G1S}=-4.0 V$ $V_{G2S}=4.0 V$	20			V
ゲート漏れ電流 (ゲート1)	I_{G1SS}	$V_{G1S}=\pm 5.0 V, V_{G2S}=0, V_{DS}=0$			± 0.1	μA
ゲート漏れ電流 (ゲート2)	I_{G2SS}	$V_{G2S}=\pm 5.0 V, V_{G1S}=0, V_{DS}=0$			± 0.1	μA
ドレイン電流	I_{DSS}	$V_{DS}=10 V, V_{G1S}=0, V_{G2S}=4.0 V$	4.0	15	25	mA
カットオフ電圧 (ゲート1)	$V_{G1S(off)}$	$V_{DS}=10 V, I_D=100 \mu A, V_{G2S}=0$		-0.90	-3.0	V
カットオフ電圧 (ゲート2)	$V_{G2S(off)}$	$V_{DS}=10 V, I_D=100 \mu A, V_{G1S}=0$		-0.8	-3.0	V
オン抵抗	$r_{DS(on)}$	$V_{GS}=0.1 V, V_{G1S}=V_{G2S}=4.0 V$		30	100	Ω
小信号増幅伝達アドミタンス	$ y_{fs} $	$V_{DS}=10 V, I_D=5.0 mA$ $V_{GS}=4.0 V, f=1.0 kHz$	8.0	16		mS
小信号入力容量	C_{iss}	$V_{DS}=10 V, I_D=5.0 mA$		4.8	6.5	pF
小信号出力容量	C_{oss}	$V_{GS}=4.0 V, f=1.0 MHz$		3.0	4.0	pF

I_{DSS} 区分/M: 4-11 mA L: 9-19 mA K: 17-25 mA